



РОГАЧОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА
(ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

21 жовтня 2012 року виповнилося 75 років від дня народження Олени Іванівни Рогачової – член-кореспондента Міжнародної термоелектричної академії, доктора фізико-математичних наук, професора, відомого вченого в галузі термоелектричного матеріалознавства.

Закінчивши 1960 року Харківський політехнічний інститут (нині – Національний технічний університет «ХПІ»), О.І. Рогачова працювала в лабораторії напівпровідників НДІ основної хімії, одночасно навчаючись в аспірантурі при кафедрі металофізики під керівництвом проф. Палатніка Л.С. 1968 року стала кандидатом технічних наук, а 1990 – доктором фізико-математичних наук за фахом «Фізика напівпровідників і діелектриків». З 1967 р. по сьогоднішній день працює в НТУ «ХПІ», з 1991 р. – професор кафедри теоретичної й експериментальної фізики, керівник лабораторії напівпровідникового матеріалознавства, на базі якої створено навчальний лабораторний практикум. Під її керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій. Професор О.І. Рогачова – член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, член секції напівпровідникового матеріалознавства Наукової Ради НАНУ з проблеми «Фізика напівпровідників»; член редколегії журналу «Термоелектрика», член Міжнародного оптичного, Українського фізичного й Термоелектричного товариств, з 2007 року – член-кореспондент Міжнародної термоелектричної академії.

Основний напрямок досліджень – розробка наукових основ ТЕ матеріалознавства, що включає в себе такі питання, як фізика фаз змінної сполуки, нестехіометрія й домішки в напівпровідниках, розмірні ефекти в наноструктурах.

Праці школи професора О.І. Рогачової добре відомі міжнародному науковому співтовариству. Вона – автор і співавтор понад 230 наукових праць (у тому числі двох монографій), багато з яких опубліковано в провідних міжнародних журналах, і майже 300 доповідей на міжнародних конференціях.

2005 р. О.І. Рогачову нагороджено пам'ятною медаллю Фонду CRDF і почесною грамотою Міністерства освіти й науки України «За значний внесок у розвиток міжнародного співробітництва між Україною і США»; 2008 р. стала лауреатом премії «Інтелект Харкова» ім. Л.С. Палатніка, 2009 р. одержала почесну грамоту Міжнародної термоелектричної академії «За досягнення в галузі термоелектричного матеріалознавства», 2010 р. нагороджена знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України.

Міжнародна термоелектрична академія, Інститут термоелектрики НАН і МОНМС України, редакція журналу «Термоелектрика» вітають шановну Олену Іванівну Рогачову з 75-річним ювілеєм, бажають міцного здоров'я, щастя, невичерпної енергії й творчих досягнень у роботі.